技術資料

近傍界用ノイズ抑制シートの伝送減衰率 А, 測定用フィクスチャの作製

林 達郎*1)

Fixture for Transmission Attenuation Power Ratio R_{tp} Measurement

of Noise Suppression Sheet

HAYASHI Tatsuro^{*1)}

電子基板や部品から発生する電磁的なノイズの対策に,近傍界用のノイズ抑制シートが利用されている. 本研究では,近傍界用ノイズ抑制シートの伝送減衰率 *R*_{tp}の測定に使用できるフィクスチャの作製を目的 に,ガラスエポキシ(FR-4)両面基板を用いたマイクロストリップラインを構成し,フィクスチャとして求 められる特性を測定した.結果として,作製したフィクスチャは,ノイズ抑制シートを装着しない単体の状 態で,測定対象周波数 0.1 GHz~3 GHz において,片側端を 50 Ω で終端したときの電圧定在波比 *VSWR* が 1.5 より小さく,また,終端を取り外して測定した透過損失 S21 の値が,無視できる程度に小さいことから,国 際規格 IEC62333-2 に準ずる *R*_{tp}の測定に使用できることを確認した.

1. 緒言

近傍界用ノイズ抑制シートは、電子基板や部品、ケーブ ルなどに貼り付けるなど近接して装着することで、電磁的 なノイズを抑制できるため、回路、基板の設計変更を行わ ずに EMC 対策が行える選択肢として利用されている.

国際規格 IEC62333-2¹)には、近傍界用ノイズ抑制シート の性能指標として、内部減結合率 R_{da} 、相互減結合率 R_{dc} 、 伝送減衰率 R_{tp} , 輻射抑制率 R_{rs} が規定されているが、なか でも R_{tp} は、ノイズ抑制シートの装着によって減衰するノ イズ量を直接的に示すことから、シートの代表的な特性値 として扱われることが多い.

本研究では、測定対象周波数 0.1 GHz~3 GHz において、 近傍界用ノイズ抑制シートの R_p 測定に使用できるフィク スチャの作製を目的に、入手しやすい低周波用のガラスエ ポキシ (FR-4) 両面基板を用いたマイクロストリップライ ンを構成し、フィクスチャに求められる特性を満足するか 検討した.

2. フィクスチャの設計

2.1 R_w測定の概要

前述のとおり、電子基板上を伝導するノイズが、ノイズ 抑制シートの装着によって減衰する量は*R*_{tp}で示される.

*R*_{tp}は、図1に示す測定系により、フィクスチャにノイズ 抑制シートを装着した際に得られる反射係数 S11 と透過係 数 S21 の測定値 S11M, S21M から、次式により求めること ができる.

$$R_{tp} = -10 \log \left\{ 10^{\frac{S21M}{10}} / \left(1 - 10^{\frac{S11M}{10}} \right) \right\} \quad (dB)$$

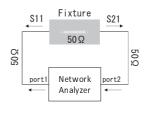


図 1 R_{tp}の測定系

2.2 フィクスチャの構成

フィクスチャは、図2に示すように、電子基板上のノイ ズ伝導ルートをマイクロストリップラインで疑似的に構成 するもので、表面の導電パターンの両端裏側に高周波用の SMA コネクタを設けて、ネットワークアナライザとの接続 に使用する.

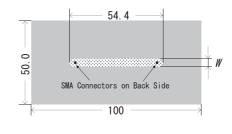


図 2 フィクスチャの形状(単位 mm)

また,ノイズ抑制シートを装着しない状態で,片側端を 50Ωで終端したときの電圧定在波比 VSWR が,測定対象周 波数において 1.5 より小さいことが,規格で求められる特 性である.

ところで、規格にはフィクスチャ用の基板として、比誘 電率*ε_yが 2.2~2.6*の高周波用基板が推奨されており、その 際の導電パターン寸法も示されている.しかし、高周波用 の基板は少量での入手性、価格に課題が残るため、一般の 回路試作に広く用いられる低周波用の基板を用いてフィク スチャを構成できれば、*R_uの*測定環境が構築しやすい.

そこで本研究では、入手しやすいガラスエポキシ (FR-4) 両面基板を用いて、フィクスチャの作製を試みた.

2.3 特性インピーダンスの検討

図1に示す測定系では、フィクスチャを含む伝送路の特 性インピーダンスを 50 Ωに整合する必要がある.

フィクスチャにガラスエポキシ(FR-4) 基板を用いる場 合,高周波用基板と比較して比誘電率が大きいため,規格 に示されたフィクスチャ表面の導電パターン寸法のうち, 幅 W に関する推奨値 4.40±0.05 mm では,特性インピーダ ンスが 50 Ω に整合せず, W の設計変更が必要と考えられ る.

ここで,マイクロストリップラインの特性インピーダン ス Z₀は,近似的に次式²⁾で示される.

$$Z_{0} = \frac{87}{\sqrt{1.41 + \varepsilon_{\gamma}}} \times \ln\left(\frac{5.98h}{0.8W + t}\right) \quad (\Omega)$$

 $\varepsilon_{\gamma}: 基板の比誘電率$
 $h: 基板の厚み(m)$
 $W:線路幅(m)$
 $t:線路厚み(m)$

使用するガラスエポキシ(FR-4) 基板の比誘電率 ϵ_{γ} が4.5, 基板の厚みhが1.6 mm,線路厚みtが0.035 mmとしたと き、上式を用いて線路の特性インピーダンス Z_0 が50Ωに 近い値となるWを概算すると約3mmであるため、この値 を用いてさらに検討を進める.

2.4 シミュレーションによる VSWRの計算

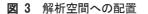
伝送路の特性インピーダンスの整合状態は、フィクスチャの片側端を 50 Ω で終端したときの反射レベルと相関するため、*VSWR*で確認することができる.

前節で得られた Wの妥当性ならびに、Wが変化したときの許容範囲を調べるため、測定対象周波数を拡張した 0.1 GHz~4 GHz における VSWR をシミュレーション ³⁾により計算し、規格で求められる特性と比較検討した.

フィクスチャを解析空間に配置した様子を図3に示す. その際,簡単のためフィクスチャ表面の導電パターンの端 部は,図2に示すように丸めず,角状とした.

Wを 2.50 mm~3.50 mm の間で, 0.25 mm 刻みで 5 種類 変化したときの VSWR を計算した結果を図 4 に示す.





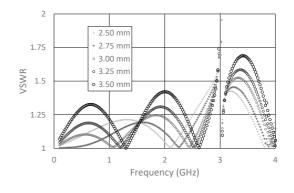


図 4 VSWRの計算結果

測定対象周波数の 0.1 GHz~3 GHz に着目すると, Wが いずれの場合も、3 GHz 付近の一部を除き,特性インピー ダンスの整合によって VSWR は 1.5 より小さいと予想され, 規格で求められる特性を概ね満たすと考えられる.一方, 3 GHz 付近の極大を示す部分においては,定在波が生じる 可能性が示唆される.

Wが最も小さい 2.50 mm のときは,3 GHz 近傍における VSWR の立ち上がりが顕著であること,また,Wが最も大 きい 3.50 mm のときは,全ての周波数帯において VSWR が 増大する傾向にあることから,Wは 2.75 mm~3.25 mm の 範囲内にあることが望ましいと考えられる.

最後に, Wが 3.00 mm のとき, 片側端を 50 Ω で終端し た場合の S11 と, 終端を外して S21 を計算した結果を図 5 に示す.

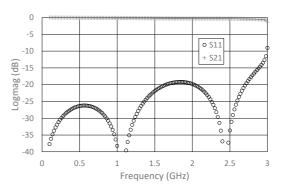


図 5 S11, S21 の計算結果

S11の計算結果より、3 GHz 付近における値の上昇、即 ち反射の増加が予想されること、また、S21の計算結果か ら,測定対象周波数の全域において値がほぼ零に近く,フィクスチャ内で生じる透過減衰は,極めて小さいことが予想される.

3. フィクスチャの作製と評価

3.1 基板の加工

前章の検討結果をもとに、ガラスエポキシ(FR-4)両面 基板を用いて、フィクスチャの作製を行った.

作製は, 基板切断, 導電パターン部のマスキング, エッ チング, 穴あけ加工, SMA コネクタ取り付けの手順で進め, 全てを手作業で行った.フィクスチャの外寸は, 図2にし たがった.また, 導電パターンの幅 Wは, 結果的に前章で 得られた許容範囲内である 3.25 mm となった.

なお,定在波の発生を抑制する目的で,導電パターンの 端部は図2に示すように,丸く加工した.

フィクスチャの外観を図6に示す.



図6 フィクスチャの外観

3.2 VSWRの測定と評価

作製したフィクスチャにノイズ抑制シートを装着しない 単体の状態で,測定対象周波数 0.1 GHz~3 GHz において, 片側端を 50 Ω で終端したときの VSWR を測定した.測定 には,ネットワークアナライザを使用し,終端にはネット ワークアナライザ校正用の 50 Ω 負荷を使用した.

測定結果に加え, 導電パターンの幅 W が 3.25 mm のときの VSWR をシミュレーションで計算した結果を重ね合わせたグラフを図7に示す.

これより,作製したフィクスチャの VSWR の測定値は, 測定対象周波数の全域において 1.5 より小さく,フィクス チャに求められる特性を満足すると評価できる.また,シ ミュレーションの際に 3 GHz 付近に予想された極大値は, 現れていない.

次に、ノイズ抑制シートを装着しない単体の状態で、片 側端を 50 Ω で終端したときの S11 と、終端を取り外した ときの S21 を測定した結果を図 8 に示す.

図5に示した計算結果と比較して,測定結果ではS11の 3GHz付近に予想された値の上昇は生じておらず,反射の 増加はみられない.また,S21については,計算結果と同 様に測定対象周波数の全域において値が零に近いことから, フィクスチャ内で生じる透過損失は無視できる程度に小さ いと評価できる.

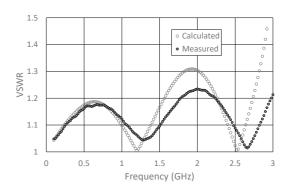


図 7 VSWRの計算結果と測定結果

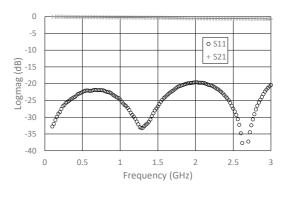


図 8 S11, S21の測定結果

4. 考察

前章までの検討で,作製したフィクスチャが,規格に求 められる特性を満足する結果が得られた.

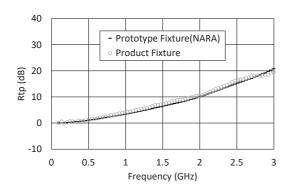
ところで、実際のノイズ抑制シートの測定においては、 シートとフィクスチャの密着性不良が原因で、測定誤差が 生じる恐れがある.また、その原因としてフィクスチャの 導電パターン上の SMA コネクタの芯線処理の不良や、芯 線とパターンを接合するハンダによる隆起が考えられる.

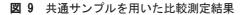
そこで、作製したフィクスチャが、実際のノイズ抑制シートの R_{tp} 測定において正しく機能するか考察するため、 共通サンプルを用いて、作製したフィクスチャを使用して 得られる R_{tp} と、高周波用基板で構成された市販のフィク スチャを使用して得られる R_{tp} の比較測定を行った.

共通サンプルには、樹脂にカーボンを添加したシートを 使用し、測定で得られる *S11M*, *S21M* を用いた R_{tp} の算出 には、**2.1** に示した数式を用いた.

比較測定の結果を図9に示す.

これより,測定対象周波数 0.1 GHz~3 GHz において,作 製したフィクスチャを使用して得られる R_p は,市販のフ ィクスチャを使用して得られる R_p とほぼ近似しており, ノイズ抑制シートを装着する際に生じる物理的な隙間など に起因する誤差は抑制されているものと考察できる.





5. 結言

近傍界用ノイズ抑制シートの伝送減衰率 *R*_{tp} の測定に使用できるフィクスチャの作製を目的に,ガラスエポキシ (FR-4)両面基板を用いたマイクロストリップラインを構

成し,フィクスチャに求められる特性を測定した.

結果として,作製したフィクスチャは,測定対象周波数 0.1 GHz~3 GHz において片側端を 50 Ω で終端したときの *VSWR* が 1.5 より小さく,また,終端を取り外して測定した 透過損失 S21 の値がほぼ零であることから, IEC62333-2 に準ずる $R_{\rm p}$ の測定に使用可能であることを確認した.

さらに共通サンプルを用いて、市販のフィクスチャを使用して得られる *R*_{tp} との比較測定を行った結果から、作製したフィクスチャが実際のノイズ抑制シートの *R*_{tp} 測定において、正常に機能することを確認した.

今後の課題として、測定対象周波数の広帯域化や、輻射 抑制率 R_{IS}測定への転用の可能性が挙げられる.

謝辞

本研究の実施にあたり,地方独立行政法人大阪産業技術 研究所和泉センターの伊藤盛通主任研究員にご協力を頂き ました.

なお,本研究で使用した機器は,公益財団法人 JKA の「機 械振興補助事業」により導入,設置したものである.



参考文献

- International Electrotechnical Commission : IEC62333-2, INTERNATIONAL STANDARD, 2006
- 2) 伊藤健一:分布定数回路のはなし, pp.96-97, 日刊工業 新聞社, 2003
- 3)小暮裕明:電磁界シミュレータで学ぶワイヤレスの世界, pp.39-42, CQ 出版社, 2001